

令和7年12月1日

委員各位

応用物理学会
半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会
委員長 小椋 厚志

半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会
第13回研究会開催通知

日時： 2026年3月9日（月）13:00～17:30

場所： 明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント1階 グローバルホール

テーマ：「窒化物半導体の先端分析・評価技術の最前線」

世話人：上田 修（明治大）、酒井 朗（大阪大）、三宅 秀人（三重大）、出浦 桃子（早稲田大）

プログラム：

13:00～13:05 開会の挨拶 小椋 厚志（明治大）

13:05～13:10 はじめに 上田 修（明治大）

13:10～13:50 ナノビーム XRD を用いた GaN 系材料・デバイスの高精度評価 酒井 朗（大阪大）

13:50～14:30 多波励起放射光 XRT および TEM による GaN 結晶中の転位の多角的評価
姚 永昭（三重大）

14:30～15:10 GaN 系デバイスプロセス開発における TEM 応用評価 五十嵐 信行（名古屋大）

15:10～15:25 休憩

15:25～16:05 GaN 系材料の先端顕微鏡法へのインフォマティクス応用 富谷 茂隆（奈良先端大）

16:05～16:45 大口径 GaN ウエハの光学特性評価用全方位フォトルミネッセンス分光法の開発
小島 一信（大阪大）

16:45～17:25 ラマン分光法による c 面 GaN の面内異方性歪の評価 武内 一真（京セラ）

17:25～17:30 おわりに 酒井 朗（大阪大）

18:00～20:00 意見交換会（明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント 17階
グローバルラウンジ）

以上